

## 产品编号: RG0603A500J3

### 特点

主要应用于微波集成电路模块, 如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路;  
降低信号电平、源与负载之间的匹配, 低寄生参数、使用频率高。  
可焊性与键和性能良好。

### 特性参数

外观: 金层表面光洁, 无外来杂质污染, 瓷体表面无裂纹。  
金属毛刺小于 20um。  
键合性能: 至少承受 6gf 拉力 (25um 直径金丝)。  
膜层可焊性: 支持金锡合金焊接, 5 秒浸润。  
膜层耐高温: 400°C5 分钟、180°C2 小时不变色, 不气泡。  
额定功率: 2W

电阻值	频率 (GHZ)	阻值精度	回损最小值
50 Ω	18GHz	±5%	20DB

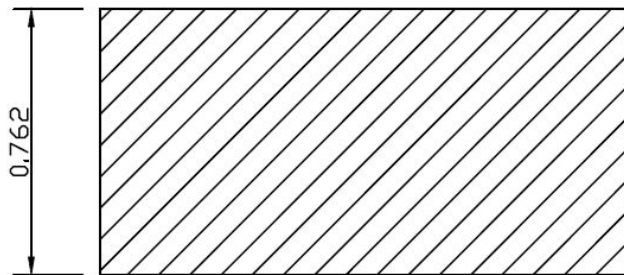
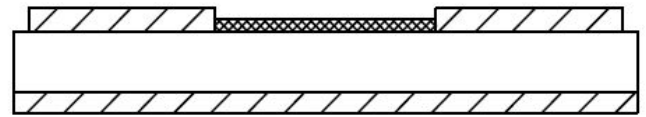
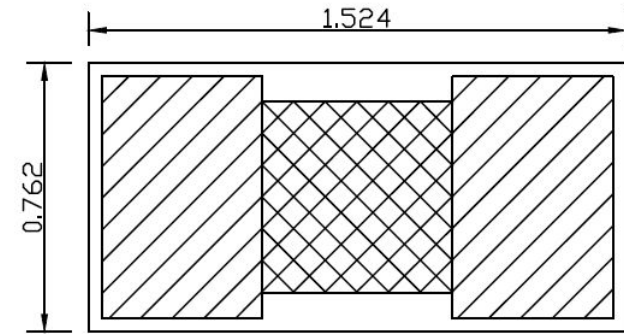
### 仅正面金属化

金属化结构为 TaN/TiW/Au  
TaN: 符合方阻要求  
TiW: 300~500A  
Au: 2.5uM min

### 基片材质

99.6%氧化铝基片, 厚度 0.254mm

### 尺寸规格



金属化区域



电阻区域